

Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation interne du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d'application des dispositions de sûreté interne d'établissement prévues par l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique ;

Vu le décret exécutif n° 12-316 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 portant création du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne du centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique désigné ci après « le centre ».

Art. 2. — Sous l'autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, en divisions de recherche, en ateliers et en services communs.

Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de deux (2), sont constitués par :

— le département de l'information scientifique, des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche ;

— Le département des équipements scientifiques de réalisation et caractérisation des dispositifs semi-conducteurs.

Art. 4. — Le département de l'information scientifique, des relations extérieures et de la valorisation des résultats de la recherche est chargé :

— d'initier et promouvoir le partenariat scientifique avec les établissements nationaux et internationaux dans les domaines de vocation du centre ;

— d'organiser des manifestations scientifiques relevant du domaine de compétence du centre ;

— de proposer et mettre en œuvre des mesures incitatives de promotion de la valorisation des résultats de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines de vocation du centre ;

— de promouvoir l'information scientifique et technique dans le domaine d'intervention du centre ;

— de proposer toute mesure d'intégration des publications scientifiques du centre à une bibliothèque virtuelle et d'en faciliter l'accès aux utilisateurs ;

— de mettre en place un système approprié de conservation des archives scientifiques du centre.

Il est organisé en trois (3) services :

— service des relations extérieures et de la communication ;

— service de valorisation des résultats de la recherche ;

— service de la documentation scientifique et technique.

Art. 5. — Le département des équipements scientifiques de réalisation et caractérisation des dispositifs semi-conducteurs est chargé :

— de la gestion des stations technologiques de réalisation des dispositifs semi-conducteurs pour l'énergétique ;

— du suivi et du développement de nouveaux moyens technologiques de réalisation de dispositifs de conversion d'énergie ;

— de la gestion des moyens de caractérisation des semi-conducteurs ;

— du suivi et du développement des nouveaux moyens technologiques de caractérisation ;

— du pilotage informatique des équipements scientifiques ;

— de la simulation des performances des équipements et des procédés des semi-conducteurs pour l'énergétique ;

— de la maintenance et de l'entretien des équipements scientifiques et des salles technologiques.

Il est organisé en quatre (4) services :

— service « stations technologiques de réalisation des dispositifs semi-conducteurs » ;

— service « caractérisation des matériaux et dispositifs semi-conducteurs » ;

— service « informatique et calcul scientifique » ;

— service « maintenance et entretien des équipements scientifiques ».

Art. 6. — Est rattaché au secrétaire général le bureau de la sûreté interne.

Art. 7. — Les services administratifs sont chargés :

- d'élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines ;
- d'assurer le suivi de la carrière des personnels du centre ;
- d'élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre ;
- d'élaborer le projet de budget de fonctionnement et d'équipement du centre et d'en assurer l'exécution après approbation ;
- de tenir la comptabilité générale du centre ;
- d'assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre ;
- d'assurer la gestion des affaires contentieuses et juridiques du centre ;
- d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du centre ;
- de tenir les registres d'inventaires du centre ;
- d'assurer la conservation et l'entretien des archives du centre.

Les services administratifs, au nombre de trois (3), sont organisés en :

- service du personnel et de la formation ;
- service du budget et de la comptabilité ;
- service des moyens généraux.

Art. 8. — Les divisions de recherche, au nombre de quatre (4), sont constituées par :

- la division « croissance cristalline des semi-conducteurs et procédés métallurgiques » ;
- la division « développement des dispositifs de conversion à semi-conducteurs » ;
- la division « couches minces, surfaces et interfaces » ;
- la division « technologies émergentes des semi-conducteurs pour l'énergétique ».

1 — La division « croissance cristalline des semi-conducteurs et procédés métallurgiques » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

- le traitement et l'enrichissement de la silice ;
- la purification par voie chimique et pyrométallurgique des matériaux pour le photovoltaïque ;
- les procédés de cristallogénèse de matériaux semi-conducteurs par diverses techniques de croissance cristalline ;
- la modélisation et la simulation numériques des procédés de cristallogénèse.

2 — La division « développement des dispositifs de conversion à semi-conducteurs » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

- les procédés technologiques de dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin ;

- les nouveaux concepts et structures photovoltaïques innovantes ;

- le développement de dispositifs structurés en couches minces ;

- la modélisation et la simulation des dispositifs.

3 — La « division couches minces, surfaces et interfaces » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

- la croissance de couches minces semi-conductrices ;
- la physico-chimie des surfaces et interfaces ;
- la surface à caractère fonctionnel ;
- l'électrochimie des matériaux.

4 — La division « technologies émergentes des semi-conducteurs pour l'énergétique » est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur :

- les nanomatériaux pour la conversion et le stockage de l'énergie ;
- les nouveaux matériaux et concepts pour l'optoélectronique ;
- les technologies à base de polymères ;
- les nanoparticules et procédés plasma pour l'énergétique ;
- les matériaux hybrides pour la conversion.

Art. 9. — Les ateliers, au nombre de quatre (4), sont constitués par :

- l'atelier d'élaboration du silicium ;
- l'atelier de traitement des effluents ;
- l'atelier de mécanique et d'électronique ;
- l'atelier d'encapsulation des dispositifs semi-conducteurs.

Art. 10. — Le service commun créé selon les dispositions de l'article 36 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, est placé sous la responsabilité d'un chef de service et est composé de sections.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.

Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique

Rachid HARAOUBIA

Pour le ministre des
finances

le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL